2N6424 2N6425

SILICON PNP POWER TRANSISTORS



www.centralsemi.com

DESCRIPTION:

The CENTRAL SEMICONDUCTOR 2N6424 and 2N6425 are silicon PNP power transistors designed for high speed switching and high voltage amplifier applications.





MAXIMUM RATINGS: (T _C =25°C) Collector-Base Voltage	SYMBOL V _{CBO}	2N6424 250	2N6425 325	UNITS V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	225	300	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	6.	.0	V
Continuous Collector Current	I_{C}	1.	.0	Α
Peak Collector Current	I _{CM}	2.	.0	Α
Continuous Base Current	I_{B}	0.	.5	Α
Peak Base Current	I _{BM}	1.	.0	Α
Power Dissipation	P_{D}	2	0	W
Operating and Storage Junction Temperature	T _J , T _{stg}	-65 to	+200	°C
Thermal Resistance	ΘJC	8.	75	°C/W

	•	J' Sig		
Thermal Re	esistance	ΘJC	8.75	°C/W
ELECTRIC	AL CHARACTERISTICS: (T _C =25°C un	less otherwise note	ed)	
SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	MAX	UNITS
I _{CBO}	V _{CB} =250V (2N6424)		0.1	mA
I _{CBO}	V _{CB} =325V (2N6425)		0.1	mA
I _{CEV}	V_{CE} =250V, V_{BE} =1.5V (2N6424)	0.5	mA	
I _{CEV}	V _{CE} =300V, V _{BE} =1.5V (2N6425)		0.5	mA
I CEV	V_{CE} =125V, V_{BE} =1.5V, T_{C} =100°C (2)	1.0	mA	
I _{CEV}	V _{CF} =200V, V _{BF} =1.5V, T _C =100°C (2N6425)		1.0	mA
ICEO	V _{CE} =125V (2N6424)		0.25	mA
ICEO	V _{CE} =200V (2N6425)		0.25	mA
	V _{EB} =6.0V		0.1	mA
	I _C =5.0mA, (2N6424)	225		V
BVCEO	I _C =5.0mA, (2N6425)	300		V
V _{CE} (SAT)	I _C =250A, I _B =25mA		2.5	V
	V _{CE} =10V, I _C =100mA		1.0	V
	V _{CE} =10V, I _C =50mA	30		
h _{FE}	V _{CE} =10V, I _C =100mA	40	200	
h_{FE}	V _{CE} =10V, I _C =250mA	25		
h _{fe}	V _{CF} =20V, I _C =100mA, f=1.0kHz	35		
	V _{CF} =10V, I _C =100mA, f=10MHz	10		MHz
C _{ob}	V _{CB} =10V, I _E =0, f=1.0MHz		120	pF
OD	OD L			R1 (2-September

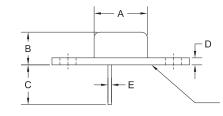
R1 (2-September 2014)

2N6424 2N6425

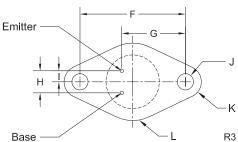
SILICON PNP POWER TRANSISTORS



TO-66 CASE - MECHANICAL OUTLINE



Seating Plane: The seating plane must be within 0.001" concave to 0.004" convex within 0.600" diameter from the center of the device.



MARKING: FULL PART NUMBER

DIMENSIONS							
	INCHES		MILLIMETERS				
SYMBOL	MIN	MAX	MIN	MAX			
A (DIA)	0.470	0.500	11.94	12.70			
В	0.250	0.340	6.35	8.64			
С	0.360	-	9.14	-			
D	0.050	0.075	1.27	1.91			
E (DIA)	0.028	0.034	0.71	0.86			
F	0.956	0.964	24.28	24.48			
G	0.570	0.590	14.48	14.99			
Н	0.190	0.210	4.83	5.33			
	0.093	0.107	2.36	2.72			
J (DIA)	0.142	0.152	3.61	3.86			
K (RAD)	0.141		3.58				
L (RAD)	0.345		8.76				

TO-66 (REV:R3)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001:
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина,

дом 2, корпус 4, литера А.